АННОТАЦИЯ

дисциплины Б1.О.17 Физика полупроводников и электроника.

Объем трудоемкости: 3 зачетных единицы (108 часов, из них - 64 часа аудиторной нагрузки: лекционных 32 ч., лабораторных 32 ч.; 37,8 часов самостоятельной работы; 6 ч. КСР)

Цель дисциплины:

Учебная дисциплина «Физика полупроводников и электроника» ставит своей целью сформировать у студентов знания о физических принципах действия, характеристиках, моделях и особенностях использования в радиотехнических цепях основных типов активных приборов, принципах построения и основах технологии микроэлектронных цепей, механизмах влияния условий эксплуатации на работу активных приборов и микроэлектронных цепей.

Задачи дисциплины:

- изучение физических принципов действия, характеристик, моделей и особенностей использования в радиотехнических цепях полупроводниковых и электровакуумных приборов;
 - формирование навыков практической работы с измерительными приборами;
- формирование умений проводить техническое обслуживание, профилактические осмотры и текущий ремонт электронной техники.

Место дисциплины в структуре ООП ВО

Дисциплина «Электроника» относится к базовой части Блока 1 учебного плана. Для успешного изучения дисциплины необходимы знания дисциплин «Электричество и магнетизм», «Радиоматериалы и радиокомпоненты», «Основы теории цепей». Освоение дисциплины необходимо для изучения дисциплин «Радиотехнические цепи и сигналы», «Схемотехника аналоговых электронных устройств» «Радиотехнические системы», «Технологии компоновки РЭА».

Требования к уровню освоения дисциплины

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся общепрофессиональных и профессиональных компетенций (О ΠK и ΠK):

Код и наименование индикатора* достиже-	Результаты обучения по дисциплине						
ния компетенции	(знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельности))						
ОПК-1 Способен использовать положения, законы и методы естественных наук и математики для ре-							
шения задач инженерной деятельности							
ИОПК-1.1. Знает фундаментальные законы	Знает законы сохранения массы, энергии и заряда.						
природы и основные физические и матема-	Знает основы зонной теории электропроводности						
тические законы	Знает основные законы дифференциального и интегралы						
	исчисления						
ИОПК-1.2. Умеет применять физические за-	Умеет применять основы зонной теории для описания электро-						
коны и математические методы для реше-	физических характеристик полупроводников						
ния задач теоретического и прикладного ха-	Умеет применять законы квантовой механики для описания						
рактера	диффузии и дрейфа свободных носителей заряда в полупровод-						
	никах						
	Умеет применять математические методы для решения задач						
	определения электропроводности полупроводников						
ИОПК-1.3. Владеет навыками использова-	Владеет навыками использования знаний физики при расчете						
ния знаний физики и математики при реше-	электрофизических характеристик полупроводников						
нии практических задач	Владеет навыками использования знаний физики при расчете						
	электропроводности полупроводников						
	экспериментальных исследований, включая выбор техниче-						
ских средств и обработку результатов	l n						
ИПК-2.1. Знает методики проведения иссле-	Знает методики проведения исследований параметров полупро-						
дований параметров и характеристик узлов	водникового диода						
и блоков радиотехнических устройств и си-	Знает методики проведения исследований параметров биполяр-						
стем	ного и полевых транзисторов						
	Знает методики проведения исследований параметров фото- электрических и излучательных приборов						
ИПК-2.2. Умеет проводить исследования	1 1						
характеристик радиотехнических устройств	Умеет проводить исследования параметров полупроводникового диода						
и систем	Умеет проводить исследования параметров биполярного и по-						
n chetem							
	левых транзисторов						

Код и наименование индикатора* достижения компетенции	Результаты обучения по дисциплине (знает, умеет, владеет (навыки и/или опыт деятельности))			
	Умеет проводить исследования параметров фотоэлектрических и излучательных приборов			
ИПК-2.3. Владеет навыками исследования	Владеет навыками исследования параметров полупроводнико-			
характеристик радиотехнических устройств	вого диода			
и систем	Владеет навыками исследования параметров биполярного и по-			
	левых транзисторов			
	Владеет навыками исследования параметров фотоэлектриче-			
	ских и излучательных приборов			

Основные разделы дисциплины:

),c	ученовные раздены днецининым	Количество часов				
	№ раз- Наименование разделов дела		Аудиторная			Внеаудитор-
-			работа			ная работа
дела			Л	ПЗ	ЛР	CPC
	Носители заряда в полупроводниках. Гене-					
1.	рация, рекомбинация, диффузия и дрейф	20	6	-	4	6,3
	носителей заряда					
2.	Физические эффекты в полупроводниках	20	6	-	8	6,3
	Контактные и поверхностные явления в					
3.	полупроводниках. Р-п-переход. Полупро-	20	6	-	4	6,3
	водниковые диоды					
4.	Биполярные транзисторы	20	6	-	8	6,3
5.	Полевые транзисторы	20	6	-	4	6,3
h	Фотоэлектрические и излучательные полу-	8	2		4	6.2
	проводниковые приборы	0		_	4	6,3
	Итого по дисциплине:	108	32	_	32	37,8

Курсовые работы: предусмотрены

Форма проведения аттестации по дисциплине: зачет

Основная литература:

- 1. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата: в 2 ч. Ч. 1 / О. П. Новожилов. М. : Юрайт, 2017. 382 с. https://biblio-online.ru/book/9C9A15AD-47A5-4719-B5A2-E1C27357A56C.
- 2. Новожилов, О. П. Электроника и схемотехника [Электронный ресурс]: учебник для академического бакалавриата: в 2 ч. Ч. 2 / О. П. Новожилов. М. : Юрайт, 2017. 421 с. https://biblio-online.ru/book/A249DF90-9B06-4320-87A4-58BCF3A99C6D.
- 3. Миленина, С. А. Электроника и схемотехника [Электронный ресурс] : учебник и практикум для академического бакалавриата / С. А. Миленина ; под ред. Н. К. Миленина. 2-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2017. 270 с. https://biblio-online.ru/book/A6FBF178-314B-4255-96C7-9116BF1296EE.
- 4. Бурбаева, Н.В. Сборник задач по полупроводниковой электронике [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.В. Бурбаева, Т.С. Днепровская. Электрон. дан. Москва : Физматлит, 2006. 168 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/2126. Загл. с экрана.

Автор РПД: Ильченко Г.П., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры радиофизики и нанотехнологий $\Phi T \Phi$ КубГУ